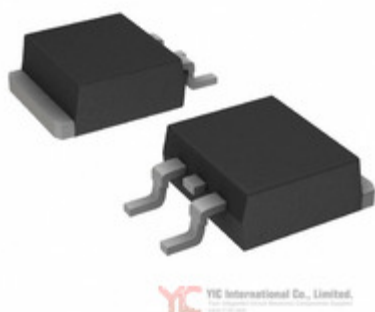

	<h2 style="color: #E67E22;">FQB8N60CTM-WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB8N60CTM-WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.5A
	Datenblätter:  FQB8N60CTM-WS.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FQB8N60CTM-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 147W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB8N60CTM-WSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7.5A (Tc) 3.13W (Ta), 147W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

FQB8N60CTM-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB8N60CTM-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB8N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB8N60CTM-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB8N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK</p>	 <p>FQB8N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>	 <p>FQB8N90CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p>	 <p>FQB8N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK</p>
 <p>FQB8N60CS FAIRCHILD FQB8N60CS FAIRCHILD</p>	 <p>FQB8N80 FAIRCHILD FQB8N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB8N60CFTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK</p>	 <p>FQB8N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB8N60CTM-WS AMI Semiconductor	FQB8N60CTM-WS Datenblatt	FQB8N60CTM-WS-Datenblätter	FQB8N60CTM-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FQB8N60CTM-WS Electronic	FQB8N60CTM-WS-Komponenten	FQB8N60CTM-WS-Verteiler	FQB8N60CTM-WS-Bild	FQB8N60CTM-WS-Teil
FQB8N60CTM-WS Preis	FQB8N60CTM-WS Hersteller	FQB8N60CTM-WS Bild	FQB8N60CTM-WS Aktie	FQB8N60CTM-WS Inventar
FQB8N60CTM-WS Neu	FQB8N60CTM-WS Original	FQB8N60CTM-WS garantiert	FQB8N60CTM-WS RFQ	FQB8N60CTM-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited